®日本国特許庁(JP)

①实用新案出類公開

⊕ 公開実用新案公報(U) 平1-106534

Mint Cl.4

識別記号

广内整理番号

❷公開 平成1年(1989)7月18日

C 03 B 37/018 G 02 B 6/00

356

A - 8821 - 4G A - 7036 - 2H

客查請求 朱請求 (全 頁)

図考案の名称

多孔質光ファイバ母材の製造装置

①実 顧 昭62-201068

顧 昭62(1987)12月29日 の出

位考 案 者

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

住友電気工業株式会社 勿出 願 人

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

20代 理 人 弁理士 光石 英俊 外1名

1. 考案の名称

多孔質光ファイバ母材の製造装置

- 2. 実用新案登録請求の範囲

記光ファイバ母材の一部を内包しうる関口部を有するダクトを設け、このダクト内の上記吹き出し口の周縁に空気または不活性ガスを取り入れる給気口を設けたことを特徴とする
多孔質光ファイバ母材の製造装置。

- 2) ダクトの横断面形状が円形または矩形である実用新案登録請求の範囲第1項記載の多孔 質光ファイバ母材の製造装置。
- 3) ダクトの材質が、SiO2, Al2O3, SiCまたはSiNのいずれかもしくはこれらを組合せたものである実用新案登録請求の範囲第1項あるいは第2項記載の多孔質光ファイバ母材の製造装置。
- 4) ダクトを組立て式とした実用新案登録請求 の範囲第1項,第2項あるいは第3項記載の 多孔質光ファイバ母材の製造装置。
- 5) ダクト内のパーナ機構の吹き出し口の周緑に設られた給気口にガラスまたはフッ素系樹脂からなるフィルターを具備した実用新案登録請求の範囲第1項~第4項のいずれか1項

記載の多孔質光ファイバ母材の製造装置。 8. 考案の詳細な説明

く産業上の利用分野>

本考案は多孔質光ファイバ母材の製造装置に関する。

#### <従来の技術>

多孔質光ファイバ母材を製造する方法として軸付け法(VAD法)、外付け法等が知られている。

VAD法は、酸水素炎中にSiCl4を投入して火炎加水分解反応により微細なSiO2の粒子を生成し、このSiO2を出発材の長手方向に堆積させて多孔質光ファイバ母材を形成する方法である。この場合、SiCl4と燃焼ガスとを噴出して反応させるバーナーを多重管構造としての一部からGeCl4等の添加物を同時に噴出反応させてGeO2等を生成し、SiO2とGeO2等とが半径方向においての空間的濃度分布となるようにしている。

外付け法は、酸水素炎中にSiCe<sub>4</sub>とGeCe<sub>4</sub>

等の添加物とを供給して火炎加水分解させ、 生成した SiO<sub>2</sub> 及び GeO<sub>2</sub> 等の微粒子を出発材 であるガラス棒心材の外周に堆積させながら、 このガラス棒心材を該心材の軸方向に移動さ せ、 SiO<sub>2</sub> 及び GeO<sub>2</sub> 等の微粒子体を軸方向に 成長させて光ファイバ母材を形成する方法で ある。

尚、屈折率分布をつけるための添加物としてGeCl4を示したが、添加物としては他にBBr3、POCl3等を用いたり、これら複数の添加物を混合して用いる場合もある。また、火炎反応の際に添加物を加えて反応させる他に、純粋なSiO2の多孔質体を作り、この多孔質体の焼結時に添加物を注入する方法も知られている。

ててで、VAD法において用いられている 従来のVAD装置を第2図を参照しながら説 明する。同図に示すように、マッフル51内 には上方からターゲット材21が吊り下げら れると共に斜め下方から酸水素パーナ31が 挿入されており、酸水素パーナ31で発生したSiO₂またはGeO₂の原料流41がターゲット材11の下端に吹き付けられて、多孔質光ファイバ母材21が成長する。マッフル51は多孔質光ファイバ母材21,ターゲット材11,酸水素パーナ31,原料流41を外気から隔離する目的でこれらを収納するものであり、一般には通常のガラス、石英質ガラスなどからなる。

#### く考案が解決しようとする問題点>

しかしながら、従来のVAD装置においては、マッフルと呼ばれる隔壁にSi〇2等の微粒子が付着,堆積する問題点があった。

すなわち、酸水素パーナ31で発生した SiO<sub>2</sub>, GeO<sub>2</sub>のうち多孔質光ファイバ母材 11に堆積できなかった余剰のガラス生成物 は図中点線の矢印で示すようにマッフル51 内部を浮遊し、その大部分は排気官61を通 じて外部へ排出されるが、その一部はマッフ ル内壁面に付着, 堆積される。そして時間と

更に、マッフル内壁面に堆積した SiO<sub>2</sub> 及び GeO<sub>2</sub> の除去,消搦に要する時間も長大であり、段取時間の低減も要求されていた。

本考案はVAD法又は外付け法において、SiO<sub>2</sub>, GeO<sub>2</sub>等のガラス生成物がマッフルに付着,堆積するのを防止することのできる多孔質光ファイバ母材の製造装置を提供することを目的とするものである。

#### <問題点を解決するための手段>

前記目的を達成する本考案の多孔質光ファ イバ母材の製造装置の構成は、光ファイバ母 材を把持して該光ファイバ母材を鉛直軸を中 心に回転させるとともに鉛直軸方向へ昇降さ せる回転昇降機構と、この回転昇降機構に取 付けられた光ファイバ母材に向けて少なくと も酸素,水素,ガラス原料を吹き出すパーナ 機構と、このパーナ機構の吹き出し口と上記 光ファイバ母材を内包するとともに空気また は不活性ガスを取り入れる給気口を有するマ ッフルと、このマッフルの上記光ファイバ母 材を挟んで上記バーナ機構の吹き出し口と対 向する位置に設けられた排気口とを有する多 孔 質 光 ファ ィ バ 母 材 の 製 造 装 置 に お い て 、 一 端は上記パーナ機構の吹き出し口を内包する よう上記マッフルに接続されるとともに他端 は上配排出口と接続され且っ上記光ファィバ 母材の一部を内包しうる関口部を有するダク トを設け、このダクト内の上記吹き出し口の

زر

周禄に空気または不活性ガスを取り入れる給 気口を設けたことを特徴とする。

#### **<作** 用 >

#### く実 施 例>

以下、本考案の好適な一実施例を図面を参照しながら説明する。

第1図は本実施例にかかる多孔質光ファイバ母材の製造装置を示す構成図である。

同図に示すように、鉛直方向へ延びるターゲット材1の上端は該クーゲット材1を鉛直軸回り回転するとともに昇降する図示しない回転昇降装置のチャックに把持されており、該ターゲット材1の下端部にはガラス微粒子が堆積されて多孔質光ファイバ母材2が形成される。

一方、酸水素バーナ3は多孔質光ファイバ母材2の下端部に斜め下方から向うようで発生したり、は B e O2の原料流4が多孔質光ファイの上または G e O2の原料流4が多孔質とファイの下端部に吹き付けられてるの下端部に吹き付けられてるの下端部に吹き付けられてるの下端部に吹き付けられたのである。とは B が成長する。と、がはないの供給がある。ないのは、がいるのは、がいるのは、がいるのは、がいるのは、がいるのが、がいるのは、ないのではないでは、ないのでは

となっている。なお、堆積作用の効率上、バーナ3は母材2の軸線に対して約0~約90 度の角度で交わる軸線上の配散するのが好ま しい。

マッフル 5 は上述の多孔質光ファイバ母材 2 及びバーナ 3 の先端部を内包するように設けられており、上記パーナ 3 の上記母材 2 を挟んで反対側のマッフル 5 の壁面には排気口 6 が設けられている。

不活性ガスは一様な流れとして排気口 6 に向って流れることになり、母材 2 に堆積しなかった余剰のガラス生成物 4 & はマッフル 5 内に流出することなく排気口 6 より排出される。

また、マッフル 5 の倒壁には給気口 9 が形成されており、マッフル 5 内の余剰の空気あるいは不活生ガスが閉口部 7 ぁからダクト 7 内に流入するので、母材 2 に沿って鉛直上方に巻き上げられる余剰のガラス生成物はこの流れがあるために、マッフル 5 内に流出する

なお、ダクトでは例えばSiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiCまたはSiCもしくはこれらを組合せたもので例えば機断面形状が円形や矩形となるように形成すればよく、好適にはマッフル 5 に対して着脱自在とするのがよい。また、清掃が容易なようにダクトで自体を例えば動方向に 2 分割して組立て式としてもよい。

以上述べた装置によれば、余剰のガラス生成物 4 a はマッフル 5 内に流出したり、ダク

ト7の内壁面に付着・堆積したりせずに排気口の内壁面に付着・堆積したりせずに排気口が、 地積層の剝離部で、堆積の別において、 多名の できるのかでは、 多名の できるのかで、 ないのの できる。

次に本実施例装置の効果を示す実験例を説明する。

堆積物の落下による母材表面の異常な突起や 傷の発生は1本もなかった。また、マッフル 内壁面には SiO<sub>2</sub> あるいは GeO<sub>2</sub> の堆積はほと んどなかった。

一方、第2図に示す従来の多孔質光ファイバ母材製造装置を使用し、上記と同様の堆積速度,収率で製造を行ったところ、堆積物の落下が原因で3本の不良品が発生した。また、マッフル内壁面の堆積層の厚さは5~6㎜であった。

#### く考案の効果>

以上、実施例とともに具体的に説明したように、本考案にかかる多孔質光ファイバ母材の製造装置によれば、SiO₂、GiO₂等のガラス生成物がマッフル内に付着、堆積するのので、ガラス生成物の発生ができるので、ガラス生成物の発生が防止できるとともにマッとを観り発生が防止できるとともにないの時間を大幅に短縮することが可能となる。

#### 4. 図面の簡単な説明

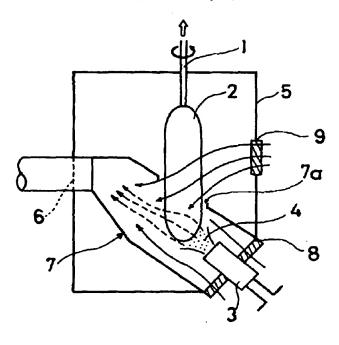
第1図は本考案の一実施例にかかる多孔質光ファイバ母材の製造装置の概略を示す構成図、第2図は従来技術にかかる多孔質光ファイバ母材の製造装置の概略を示す構成図である。

図面中、

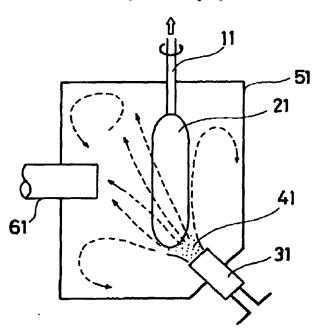
- 1 はターゲット材、
- 2 は多孔質光ファイバ母材、
- 3は酸水紫パーナ、
- 4 は原料流、
- 5はマッフル、
- 6は排気口、
- 7 はダクト、
- 7 a は 閉口部、
- 8,9は給気口である。

寒用新案登録出願人 住 友 電 気 工 業 株 式 会 社 代 理 人 弁理士 光 石 英 俊 (他 1 名)

# 第 1 図



# 第 2 図



397

 住友電気工業株式会社 光 石 英 億 (他1名)